









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD80R2K8CEATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 1.9A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD80R2K8CEATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPD80R2K8CEATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1.9A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 120µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ CE
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 Ohm @ 1.1A, 10V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	290pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.9A (Tc)

IPD80R2K8CEATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD80R2K8CEATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD80R2K8CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD80R2K8CEATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD80R280P7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 17A TO252</p>	 <p>IPD80R3K3P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 1.9A TO252-3</p>	 <p>IPD80R2K8CE infineon IPD80R2K8CE infineon</p>	 <p>IPD80R2K7C3AATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>
 <p>IPD80R450P7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 11A DPAK</p>	 <p>IPD80R2K4P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 2.5A TO252-3</p>	 <p>IPD80R360P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 13A TO252-3</p>	 <p>IPD80R4K5P7 INFINEON IPD80R4K5P7 INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD80R2K8CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD80R2K8CEATMA1 Datenblatt	IPD80R2K8CEATMA1-Datenblätter	IPD80R2K8CEATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD80R2K8CEATMA1
IPD80R2K8CEATMA1 Electronic	IPD80R2K8CEATMA1-Komponenten	IPD80R2K8CEATMA1-Verteiler	IPD80R2K8CEATMA1-Bild	IPD80R2K8CEATMA1-Teil
IPD80R2K8CEATMA1 Preis	IPD80R2K8CEATMA1 Hersteller	IPD80R2K8CEATMA1 Bild	IPD80R2K8CEATMA1 Aktie	IPD80R2K8CEATMA1 Inventar
IPD80R2K8CEATMA1 Neu	IPD80R2K8CEATMA1 Original	IPD80R2K8CEATMA1 garantiert	IPD80R2K8CEATMA1 RFQ	IPD80R2K8CEATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited